EUROPEAN PATENT OFFICE

Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

63095347

PUBLICATION DATE

26-04-88

APPLICATION DATE

09-10-86

APPLICATION NUMBER

61240258

APPLICANT: NOK CORP;

INVENTOR :

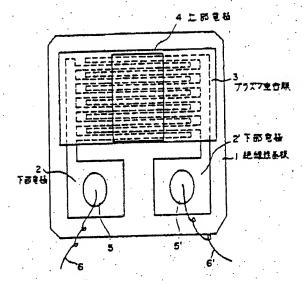
SUGIYAMA YASUSHI;

INT.CL.

G01N 27/12

TITLE

MOISTURE SENSOR



ABSTRACT:

PURPOSE: To improve resistance to water and heat and response, by covering the surfaces of conductive comb-shaped lower electrodes formed on an insulating substrate with a plasma polymer film of organic silicon compound to form an upper electrode on the plasma polymer film.

CONSTITUTION: Conductive comb-shaped lower electrodes 2 and 2' are formed on an insulating substrate 1 made of glass or the like, the surfaces thereof are covered with a plasma polymer film 3 with the thickness of about 500~20,000 in general and an upper electrode 4 is formed on the polymer film 3. That portion of drawing electrode portion not covered with the polymer film 3 is provided with leads 6 and 6' by the use of solder or silver pastes 5 and 5'. With such an arrangement, the resistance to water and heat and response can be improved.

COPYRIGHT: (C)1988,JPO&Japio

⑨ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

@公開特許公報(A)

昭63 - 95347

@Int; Cl.4

識別記号

厅内整理番号

@公開 昭和63年(1988) 4月26日

G 01 N 27/12

G-6843-2G K-6843-2G

未請求 発明の数 1 (全4頁) 等查請求

の発明の名称

湿度センサ

@特 願 昭61-240258 頭 昭61(1986)10月9日 29出

神奈川県茅ケ崎市赤松町1-1

砂出 顋

東京都港区芝大門1丁目12番15号

弁理士 吉田 俊夫 00代 理 人

- 発明の名称
- 2. 特許顕求の類関
- 1. 絶像性基板上に形成させた取電性くし型下 部は栢の表面を、有機けい紫化合物プラズマ宜合 戚で慰い、 故プラズマ風合腹上に上部電極を形成 せしめてなる程度センサ。
- 2. 有優けい現化合物プラズマ国合図がメトキ 少益またはエトキシ兹を含有する有級けい類化合 物のプラズマ単合数である特許額求の範囲第1項 記録の歴度センサ・
- 3 発明の詳細な説明...

(应集上の利用分野)

本発明は、湿度センサに関する。更に詳しくは 羽量校出型の程度センサに関する。

(従来の技術)

徒来、 高分子膜を啓録膜とする温度センサには、 抵抗校出型と容量校出型のものがある。前者は、 絶称性基板上に形成させた導電性くし型電極の表

面を高分子電解質よりなる膜状体で被取した構造 をとっており、この百分子感湿膜は結局水に相解 しるく、また数μmという膜屏のため湿度応答性 が忍く、相対程度校出範囲(約30~90%RH)も較い という欠点を一般に有している。

また後者は、抵抗検出型の経過でのくし型電極 を下部は格とし、更に高分子感起酸の上に上部電 極を形成させ、これによって高分子膜を上、下両 電板で挟んだ構造をとっており、抵抗校出型のも のと比较して、耐水性や相対温度検出範囲(0-100 %RH)の点では良いものの、やはり高分子級の厚 膜のため広答性が数分程度と応く、また膜の耐熱 性も一般に50℃程度と低いため、温度センサとし ての使用に限界がみられる。

【 苑明が解決しようとする問題点 】

本務明者は容量校出型経歴センサにみられるこ うした欠点を保消させ、時に応答性の点ですぐれ た短度センサを得るべく簡々検討を重ねた結果。 上、下面配積間に数配される路分子感恩膜を有疑 けい新化合物のプラズマ配合版で形成させること

により、かかる嫌疑が効果的に解決されることを 見出した。

【 問題点を解決するための手段 】および[作用 】

従って、本発明は容量検出型の機度センサに係り、この温度センサは、絶象性基板上に形成させた準電性くし型下部電極の表面を、有機けい素化合物のプラズマ重合膜で覆い、数プラズマ重合膜上に上部電極を形成せしめてなる。

容量検出型の程度センサは、低抗検出型のものが感視酸を形成している電解質が限度によって解離イオン量を変化させ、それによって湿度センサの抵抗を変化させるという原理に基いているのに対し、感限膜が非電解質から形成され、湿度によって一定の誘性中を有する水分子の感想酸中での濃度が変化し、それによって容量が変化するという原理に基いている。

本売明においては、かかる感傷酸として有疑けい 著化合物、好ましくはピニルトリメトキンシラン、ピニルメチルジエトキシシラン、メチルジエトキシなたはエトキシな

を含有する有機けい素化合物のプラズマ重合膜が 用いられる。有機けい素化合物のプラズマ重合膜 は、絶縁性基板との接着性にすぐれ、特にアルコ キシ基を含有する有機けい類化合物は重合膜の堆 糖速度が大きく、また膜中に Si-O-Si 結合を形成させるため傾置な膜を形成させる。

図画の係1回は、本発明に係る容量検出型の提及センサの一定様を示すそれの平面圏であり、絶象性基板1上に専電性くし型電板2、2′が形成され、その数回は一般に約500人~20000人(2μm)程度の膜厚を有する上記プラズマ重合膜3によって関われており、このプラズマ配合膜の上には上部電極4が形成されている。

このように構成される温度センザの容量検出は、下部電框2、2 1回の距離が長く、そのままでは上部電極の容量が小さいため、中国電極として作用し、結局下部電極2、2 1回に容積される容量として検出される。従って、この程度センサの等価回路は、次の如くとなる。



なお、この2、2′の符号によって投示される。 プラズマ基合膜によって使われていない取出電極 部分には、半田付けあるいは銀ペースト 5、5′ により、リード球台、6′が取り付けられている。

絶象性基板としては、一般にガラス、石英、アルミナ、セラミックスなどが用いられるが、感程素子への温度追旋性が更に良好なことが望まれる場合などには、やはり本出取人よって提案されているシリコン基板表面を散化して形成させた絶縁取(特級昭60~122,548号)なども用いることができる。

これらの絶縁性基板上へ下部電極として選載性 くし型電極を形成させるに際しては、まず絶縁性 基板上に、ステンレススチール、ハステロイC、 インコネル、モネル、金などの耐食性金属や銀、 アルミニウムなどの電極形成材料金属をスパッタ リング法、イオンプレーティング法などにより、 約0.1-0.5μ■程度の厚さの存取を形成させ、次に そこにフォトレジストパターンを形成させる。

例えばアルミニウムの場合は、このようにして 形成された電極形成材料金属符膜へのフォトレジストパターンの形成は、時知のフォトリソグラフ 工程を適用することによって行われる。即ち、金 高な限上にフォトレジストコーティングを行ない、 そこにくし型電板のパターンの陰間または陽面を 焼付けたガラス乾板を進ね、光脈射による焼付け および現像によって行われる。この後、程式化学 エッチングが行われるが、エッチング放としては、 リン酸-硬酸-無水クロム酸-水(武量比65:15:5: 15) 間合被、BHP(フッ酸系)、塩化館2飲水箱核、 可酸、リン酸-硝酸混合核などが用いられる。

あるいは、 お板上に南刺可格性樹脂のフォトレジストバターンを形成させた後、 腹次クロムおよび金を素着させ、 フォトレジストを 構剤で溶解除去する方法、 お板上に金ペーストを 用いてスクリーン印刷法を適用する方法などによっても原電性 くし型電極の形成を行なうことができる。

特開昭63-95347 (3)

このようにして絶縁性基板上に形成させた現代性くし型下部電極の表面は、 有機けい剤化合物のプラズマ取合膜で関われる。プラズマ取合は、 真空プラズマ取合製の内に有機けい剤化合物を数ミリー数Torrの圧力になる迄違入し、そこに数一数10Wの放電出力の質問波電力を供給することにより行なわれる。

その後、プラズマ瓜合の場合と同様に必要なマスキングを施し、蒸芥袋区内で企、白金などを約200~400人の窓厚で煮着させ、上部電網を形成させ、

(発明の効果)

本苑明に係る程度センサは、容量検出型のため そもそも相対程度検出範囲が広いばかりではなく、 成程膜として有機けい素化合物、特に高架橋化さ れるメトキシ茲またはエトキシおを含有する有機 けい素化合物のプラズマ型合膜が用いられている ため、耐水性、耐熱性が改善され、また応答性の 点でもすぐれている。

(夹施例)

容量がほぼ直線的に変化することが分かる。

また、この温度センサを150℃に加熱する耐熱 試験を行なうと、第3回のグラフに示されるよう な結果が得られた。

4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明に係る歴度センサの一定級の 平価図である。第2回は、この歴度センサを用い た場合の相対歴度に対する節電容量の関係を示す グラフである。また、第3回は、この程度センサ の耐熱試験の結果を示すグラフである。

(符号の説明)

1 · · · · 格核性基板

2.2 下邢電極

3・・・・プラズマ重合膜

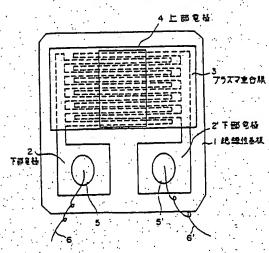
イ・・・・上部電便

次に、突旋例について本発明を説明する。 突旋例

ガラスな板上にフォトレジストによりくし型電 係と反対のパターンを形成させた後、蒸着低によりクロムを500人の腹瓜で、次いで金を1000人の 酸瓜で蒸着させた後、フォトレジストを溶解させ て、脚電性くし型電極を形成させた。

このようにして形成された容量検出型の温度センサについて、相対程度に対する静電容量を測定すると、第2回のグラフに示されるような結果が 切られた。この結果から、相対程度に対して静電

第 | 図



· 代理人

办项士 百田 世 夫

